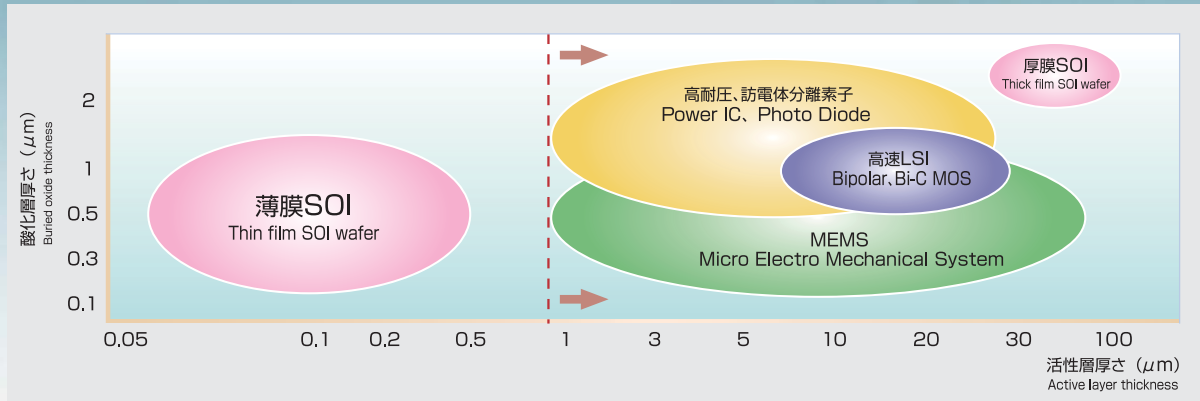


厚膜SOIウェーハ

Thick Film SOI Wafer

コンセプト Concept

パワーデバイスやMEMS等、多様な用途に使用できます
Various applications (Power devices MEMS etc.)



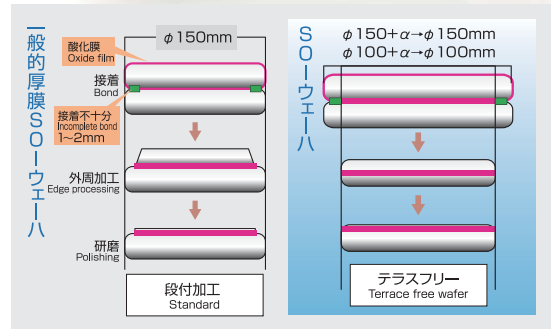
代表的製品・特長 Features

多様化するお客様のご用途に対応する製品群
Products corresponding to customer's various needs

ウェーハ直径 Diameter	100mm	125mm	150mm
面方位 Surface orientation	(100), (111), (110)		
タイプ(ドーパント) Type (Dopant)	N(Phos, As, Sb), P(Boron)		
活性層厚さ Active layer thickness	2.0~200.0μm		
活性層厚さ公差 Tolerance of active layer thickness	±0.4μm		
埋込み酸化厚さ Buried oxide film thickness	4.0μm		
埋込み酸化厚さバラツキ Tolerance of buried oxide film thickness	±5.0%以内		
ウェーハ基板厚さ Wafer substrate thickness	200~625μm	300~665μm	

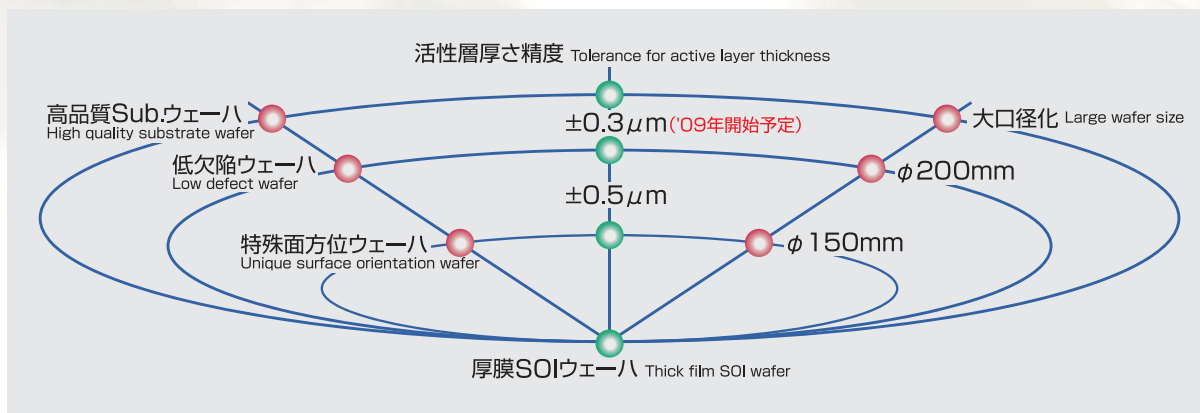
中核技術 Core technology

業界唯一のテラスフリーウェーハを実現
Realizing terrace free



今後の方向・計画 Future direction and plan

先端製品への展開 Evolution of our leading products



COVALENT

コバレントマテリアル株式会社

シリコン事業本部

東京都品川区大崎1-6-3 日精ビルディング 〒141-0032

Tel:03-5437-8415 Fax:03-5437-7433

www.covalent.co.jp